


| | |
|---|---|
|  | <h2>SI7925DN-T1-GE3</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SI7925DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 12V 4.8A 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SI7925DN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI7925DN-T1-GE3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET 2P-CH 12V 4.8A 1212-8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1V @ 250µA |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerPAK® 1212-8 Dual |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 42 mOhm @ 6.5A, 4.5V |
| Leistung - max | 1.3W |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | PowerPAK® 1212-8 Dual |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 12nC @ 4.5V |
| Typ FET | 2 P-Channel (Dual) |
| FET-Merkmal | Logic Level Gate |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 12V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 4.8A |

SI7925DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7925DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7925DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7925DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>SI7925DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 4.8A 1212-8</p> |  <p>SI7923DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 4.3A 1212-8</p> |  <p>SI7938DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p> |  <p>SI7940DP VISHAY SI7940DP VISHAY</p> |
|  <p>SI7940DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 12V 7.6A PPAK SO-8</p> |  <p>SI7925DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 4.8A 1212-8</p> |  <p>SI7925DN SI SI7925DN SI</p> |  <p>SI7938DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| SI7925DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix | SI7925DN-T1-GE3 Datenblatt | SI7925DN-T1-GE3-Datenblätter | SI7925DN-T1-GE3 PDF | Vishay / Siliconix SI7925DN-T1-GE3 |
| SI7925DN-T1-GE3 Electronic | SI7925DN-T1-GE3-Komponenten | SI7925DN-T1-GE3-Verteiler | SI7925DN-T1-GE3-Bild | SI7925DN-T1-GE3-Teil |
| SI7925DN-T1-GE3 Preis | SI7925DN-T1-GE3 Hersteller | SI7925DN-T1-GE3 Bild | SI7925DN-T1-GE3 Aktie | SI7925DN-T1-GE3 Inventar |
| SI7925DN-T1-GE3 Neu | SI7925DN-T1-GE3 Original | SI7925DN-T1-GE3 garantiert | SI7925DN-T1-GE3 RFQ | SI7925DN-T1-GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited